

6

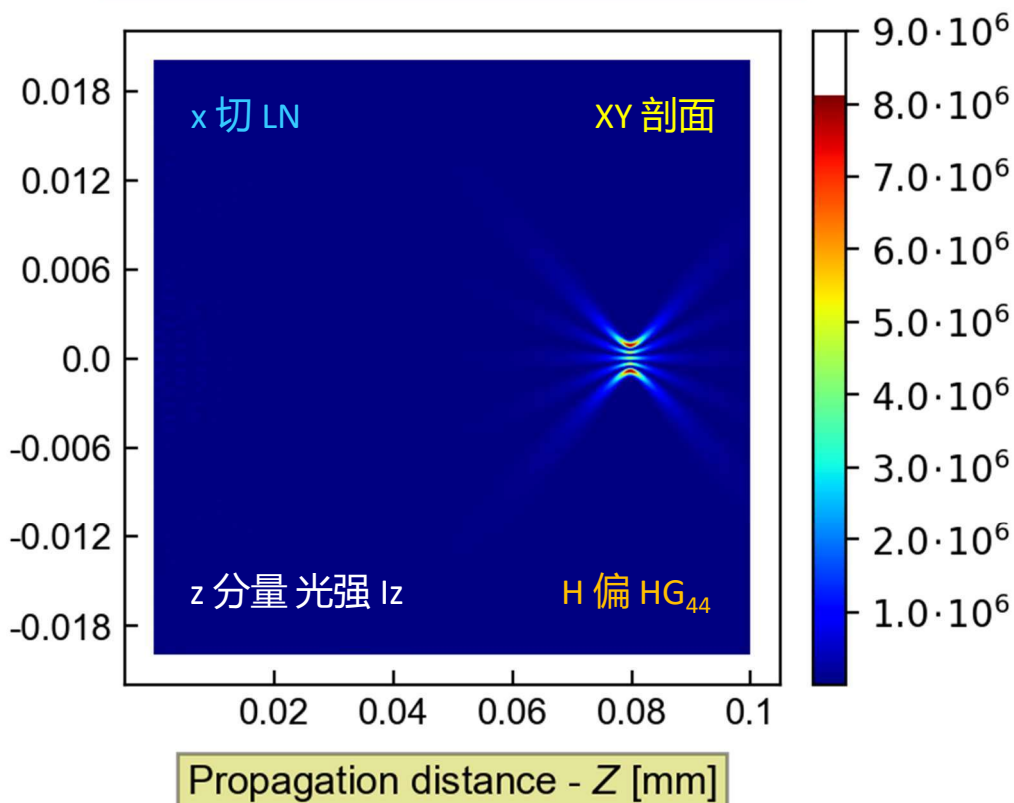
任意加工深度, N.A., 晶体, 切向, pattern (目标: z 偏 HG_{44})

100 μm 厚 x 切 LN; 晶体内: 就一个光斑;
光强 XZ, XY 剖面;
目标: 80 μm 深;

任何深度光斑: 自定义
标量全息图: H 偏 HG_{44}

H 偏标量 \rightarrow LN \rightarrow H 偏 HG_{44} ;
 $\bar{n} = 2.2291$; $z_0 = 80 \mu\text{m}$;
 $\theta = 29.18^\circ$; N.A. = 0.49;
 $\lambda = 800 \text{ nm}$; $\omega_0 = 500 \text{ nm}$;

AST - $U_{1/H_0.0\text{mm_YZ_intensity}$



AST - $U_{1/H_0.0\text{mm_XZ_intensity}$

